

專利權授權/讓與公告

公告主旨	有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立中央大學擬將其所擁有之優質專利，以授權或讓與方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提升研發成果運用效益。歡迎各界洽詢。
公告時間	111年 6月 15 日
公告內容	<p>一、申請資格：國內依中華民國法令組織登記成立之公司法人</p> <p>二、申請日期：即日起至111年 9月 15日 17 時 00 分止</p> <p>三、申請方式：請逕向本校研發處 智權技轉組 詢問相關資訊</p> <p>四、授權/讓與專利內容：詳見附件清單</p> <p>（專利技術內容請參考本校技術媒合網網頁介紹 http://ipm.ncu.edu.tw/prod.asp）</p>
聯絡人	研發處 產學營運中心智權技轉組李經理
聯絡電話	03-4227151 轉 27083
電子郵件	lizlee@ncu.edu.tw

序號	本校編號	專利名稱	公告號	國別	發明代表人
1	101056US	FIELD EFFECT TRANSISTOR DEVICE	9,093,510	美國	綦振瀛
2	101056TW	場效電晶體裝置及其製造方法	1500157	台灣	綦振瀛
3	101056CH	場效電晶體裝置及其製造方法	CN103633132	中國	綦振瀛
4	103071TW	半導體裝置與其之製造方法	1535007	台灣	綦振瀛
5	103071US	Semiconductor Device and Manufacturing Method Thereof	9,070,708	美國	綦振瀛
6	103071CH	半導體裝置與其之製造方法	ZL 201410042076.0	中國	綦振瀛
7	104042US	SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	10,283,631	美國	綦振瀛
8	104042TW	半導體裝置及其製作方法	1621265	台灣	綦振瀛
9	104042CH	半導體裝置及其製作方法	CN106158926	中國	綦振瀛
10	104044US	DIODE DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	9,640,672	美國	綦振瀛
11	104044TW	二極體元件及其製造方法	1560890	台灣	綦振瀛
12	104044CH	二極管元件及其製造方法	CN106158984	中國	綦振瀛